

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Сошников И.П., Петров В.А., Проскуряков Ю.Ю., Кудряшов Д.А., Нащекин А.В., Цырлин Г.Э., Trehanne R., Durose K.

Формирование структур с бескаталитическими нитевидными нанокристаллами CdTe 865

● Электронные свойства полупроводников

Атакулов Ш.Б., Зайнолобидинова С.М., Набиев Г.А., Набиев М.Б., Юлдашев А.А.

Теория явлений переноса в поликристаллических пленках халькогенидов свинца. Подвижность. Невырожденная статистика 869

Филиппов В.В., Бормонтов Е.Н.

Особенности распределения электрических полей в пластинах анизотропных полупроводников в поперечном магнитном поле 874

Ромака В.А., Rogl P., Ромака В.В., Стадник Ю.В., Hlil E.K., Крайовский В.Я., Горынь А.М.

Эффект аккумуляции избыточных атомов Ni в кристаллической структуре интерметаллического полупроводника $n\text{-ZrNiSn}$ 882

Пляцко С.В., Рашковецкий Л.В.

Новые акцепторные центры фоновых примесей в $p\text{-CdZnTe}$ 890

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Бабаев А.А., Кудоярова В.Х.

Поглощение и фотолюминесценция тройных наноструктурированных стеклообразных полупроводниковых систем Ge-S-Ga(In) 899

Казанский С.А., Щеулин А.С., Ангервакс А.Е., Рыскин А.И.

Поглощение и фотоионизация донорного уровня в полупроводниковых кристаллах CdF₂ 902

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Косяченко Л.А., Юрценюк Н.С., Раренко И.М., Склярчук В.М., Склярчук О.Ф., Захарук З.И., Грушко Е.В.

Механизмы переноса заряда в диодах Шоттки на основе низкоомного CdTe:Mn 907

Максименко Л.С., Матяш И.Е., Мищук О.Н., Руденко С.П., Сердега Б.К.

Топологический размерный эффект в кластерных пленках диоксида олова, полученных методом реактивного распыления 916

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Севрюк В.А., Брунков П.Н., Шальнев И.В., Гуткин А.А., Климко Г.В., Гронин С.В., Сорокин С.В., Конников С.Г.

Статистический анализ топографических АСМ-изображений самоорганизованных квантовых точек 921

Кульбачинский В.А., Лунин Р.А., Юзеева Н.А., Васильевский И.С., Галиев Г.Б., Климов Е.А.

Замороженная фотопроводимость и подвижности электронов в структурах с квантовой ямой $\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}/\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}/\text{In}_{0.52}\text{Al}_{0.48}\text{As}/\text{InP}$ 927

Катеринчук В.Н., Кудринский З.Р., Хомяк В.В., Орлецкий И.Г., Нетяга В.В.

Электрические и фотоэлектрические свойства анизотропных гетеропереходов $n\text{-CdO}-p\text{-InSe}$ 935

Малышев К.В.

Терагерцовая электролюминесценция сверхрешеток Фибоначчи 939

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Анисимова Н.И., Бордовский В.А., Грабко Г.И., Кастро Р.А.

Инфранизкочастотный фотодиэлектрический отклик аморфных слоев As₂Se₃ 944

Комолов А.С., Лазнева Э.Ф., Пшеничнюк С.А., Гавриков А.А., Чепилко Н.С., Томилов А.А., Герасимова Н.Б., Лезов А.А., Репин П.С.

Электронные свойства пограничной области между пленками фторозамещенного и незамещенного фталоцианина меди 948

● Углеродные системы

Алисултанов З.З.

Адсорбция на перестраиваемом бислое графена. Модельный подход 954

● Физика полупроводниковых приборов

Витухновский А.Г., Ващенко А.А., Лебедев В.С., Васильев Р.Б., Брунков П.Н., Бычковский Д.Н.

Механизм передачи электронного возбуждения в органических светоизлучающих устройствах на основе полупроводниковых квантовых точек 962

Кюрегян А.С.

Теория стационарных плоских волн туннельно-ударной ионизации 970

Олих О.Я.

Влияние ультразвукового нагружения на протекание тока в структурах $Mo/n-n^+-Si$ с барьером Шоттки 979

Малеев Н.А., Кузьменков А.Г., Кулагина М.М., Задиранов Ю.М., Васильев А.П., Блохин С.А., Шуленков А.С., Трошков С.И., Гладышев А.Г., Надточий А.М., Павлов М.М., Бобров М.А., Назарук Д.Е., Устинов В.М.

Пространственно-одномодовые полупроводниковые вертикально излучающие лазеры с неплоским верхним распределенным брэгговским отражателем 985

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Галиев Г.Б., Пушкарев С.С., Васильевский И.С., Климов Е.А., Имамов Р.М.

Исследование свойств новых конструкций метаморфного буфера $InAlAs$ на подложках $GaAs$ с распределенной компенсацией упругих деформаций 990

Вирт И.С., Рудый И.А., Курило И.В., Лопатинский И.Е., Линник Л.Ф., Тетёркин В.В., Потера П., Лука Г.

Свойства тонких пленок Sb_2S_3 и Sb_2Se_3 , полученных методом импульсной лазерной абляции 997

Gassoumi Malek, Mosbahi Hana, Zaidi Mohamed Ali, Gaquiere Christophe, Maaref Hassen

Effect of surface passivation by SiN/SiO_2 of $AlGaIn/GaN$ high-electron mobility transistors on Si substrate by deep level transient spectroscopy method 1002

● **Персоналии**

Стафеев Виталий Иванович

(01.01.1929–16.02.2013) 1006